



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

HBU3150A

对应国外型号
BU3150

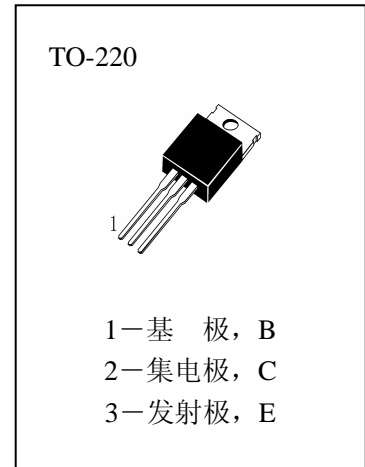
■ 主要用途

电子镇流器、节能灯、充电器及各类功率开关电路。

■ 外形图及引脚排列

■ 极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

- T_{stg} ——贮存温度…………… -65~150 $^\circ\text{C}$
- T_j ——结温…………… 150 $^\circ\text{C}$
- P_C ——集电极耗散功率 ($T_c=25^\circ\text{C}$) …………… 40W
- V_{CBO} ——集电极—基极电压…………… 1000V
- V_{CEO} ——集电极—发射极电压…………… 530V
- V_{EBO} ——发射极—基极电压…………… 9V
- I_C ——集电极电流 (DC) …………… 1.5A
- I_C ——集电极电流 (脉冲) …………… 3A



■ 电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
V_{CBO}	集电极—基极击穿电压	1000			V	$I_C=1\text{mA}, I_E=0$
V_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	530			V	$I_C=5\text{mA}, I_B=0$
V_{EBO}	发射极—基极击穿电压	9			V	$I_E=1\text{mA}, I_C=0$
I_{CEO}	集电极—发射极截止电流			100	μA	$V_{CE}=500\text{V}, I_B=0$
I_{CES}	集电极—发射极截止电流			10	μA	$V_{CB}=920\text{V}, I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			10	μA	$V_{EB}=9\text{V}, I_C=0$
H_{FE}	直流电流增益	12				$V_{CE}=10\text{V}, I_C=1\text{mA}$
		15		40		$V_{CE}=10\text{V}, I_C=0.4\text{A}$
		6				$V_{CE}=10\text{V}, I_C=1\text{A}$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			1	V	$I_C=1\text{A}, I_B=0.25\text{A}$
$V_{BE(sat)}$	基极—发射极饱和电压			1.4	V	$I_C=1\text{A}, I_B=0.25\text{A}$
t_{STG}	贮存时间	2		6	μS	$V_{CC}=5\text{V}, I_C=0.5\text{A}(\text{UI9600})$



■ 特性曲线

Figure 1. Static Characteristics

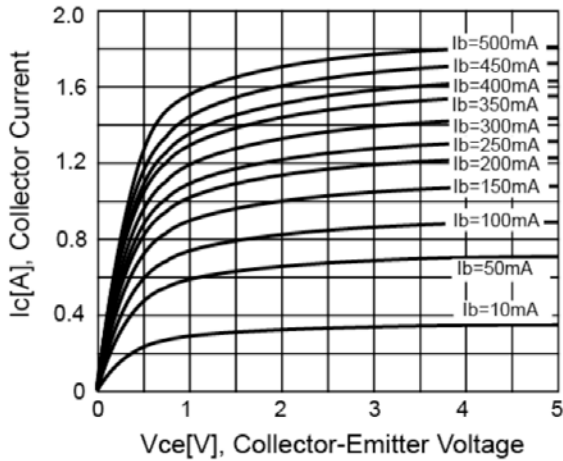


Figure 2. DC Current Gain

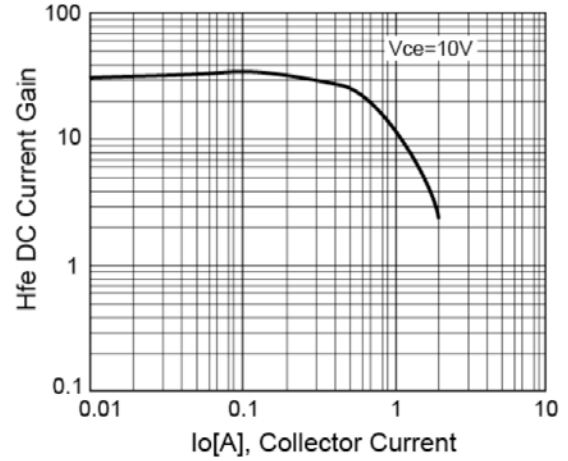


Figure 3. Vce(sat) v.s. Vbe(sat)

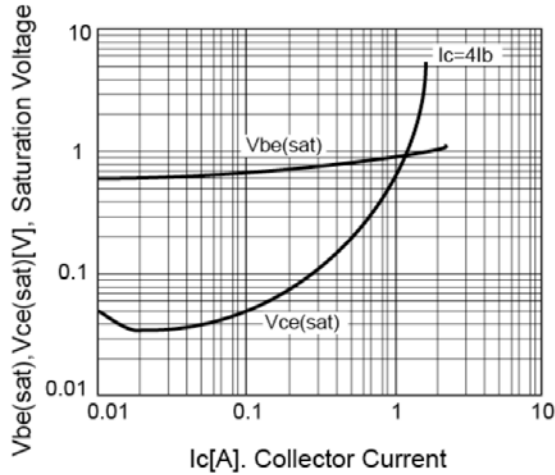


Figure 4. Power Derating

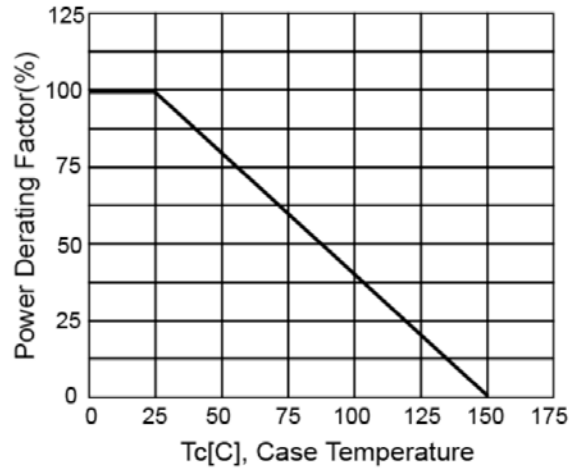


Figure 5. Reverse Bias SOA

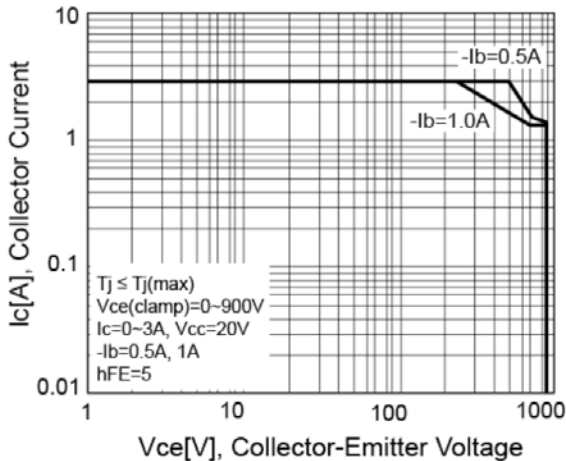


Figure 6. Safety Operating Area

